磁性 AFM 探針を用いた Fe₃Si ナノドットの電子輸送特性評価

Magnetic-Field Dependent Electron Transport of Fe₃Si Nanodots

by Using a Magnetic AFM Probe

名大院工 ⁰張 海, 満行 優介, 牧原 克典, 池田 弥央, 大田 晃生, 宮崎 誠一

Nagoya Univ., °Hai Zhang, Yuusuke Mitsuyuki, Katsunori Makihara, Mitsuhisa Ikeda, Akio Ohta

and Seiichi Miyazaki

E-mail: miyazakilab@googlegroups.com

序>これまでに、熱酸化 SiO₂薄膜上の Fe/Si/Fe 極薄積層膜をリモート H₂プラズマ処理(外部非加熱)することで、Fe₃Si ナノドットを高密度(面密度: ~10¹¹cm⁻²)・一括形成でき、室温磁化特性から、形成した ナノドットの保磁力が室温で~10Oe であることを報告した[1]。本研究では、極薄 SiO₂ 上に高密度形成 した Fe₃Si ナノドットにおいて、外部磁場印加に伴う電子輸送変化を磁性 AFM 探針を用いて評価した。 実験>p-Si(100)基板上に膜厚~3.0nmのSiO₂を形成後、Fe(~2.0nm)/Si(~2.0nm)/Fe(~1.5nm)積層構造を電子 線蒸着により連続堆積した。その後、60MHz高周波電力の誘導結合により励起・生成した高密度水素 プラズマを用いて、Fe/Si/Fe積層膜表面に外部非加熱でリモートプラズマ処理を施し、Fe₃Siナノドット (平均ドット高さ: ~8nm, 面密度: 5.0×10¹¹cm⁻²)を形成した。Si基板裏面には、AI電極を蒸着形成した。

Fe₃Siナノドットの局所電子輸送特性の評価は、磁性 CoPtCrコートSi探針(H_c=220Oe)を用い、外部磁場は、 試料直下に磁石を配置することで印加した。

結果及び考察>磁性AFM 探針を用いて測定した外部 磁場非印加時における局所電流-電圧特性(Fig. 1)は、 Tip バイアス-3.5V 近傍で電流レベルの増大が僅かな がら認められるのに対し、初期探針磁化方向と同方向 に外部磁場 0.5kOe を印加した場合、-0.3V で大幅な電 流レベルの増大が確認された。また、0.5kOe 以上の 外部磁場強度では、しきい値電圧の顕著な変化は認め られなかった。表面形状像では外部磁場の印加による 顕著な変化は認められないことから、Fig.1の結果は 探針の物理的接触の変化では説明できない。さらに、 探針磁化方向と同方向に印加した後、逆方向磁場 0.5kOe 印加した場合(Fig.2)では電流レベルが低減し、 再度同一方向に外部磁場を印加した場合、大幅な電流 レベルの増大が認められた。これらの結果は、ドット の保磁力より大きな外部磁場を印加した場合、磁性コ ート AFM 探針と Fe₃Si ナノドットの磁化方向が揃う ことで、抵抗が減少し、I-V 特性のしきい値電圧が低 減すると考えられる。外部磁場 1.5kOe 未満では探針 の磁化方向は反転しないことがわかっており[2]、逆 方向に外部磁場 0.5kOe を印加した場合に観測された 抵抗減少は Fe₃Si ナノドットの磁化が反転し、探針と 反平行方向になったためと解釈できる。

結論>外部磁場印加時におけるFe₃Siナノドットの局 所電気伝導特性を磁性AFM探針を用いて評価した結 果、磁気抵抗効果が関与した電子輸送変化を室温で観 測できた。

文献>[1] 張 他、第 62 回春季応用物理学会 (13a-A25-10)2014 年 [2] 壁谷 他、第 75 回秋季応用 物理学会(19p-A6-15)2014 年

謝辞>試料作成は、名古屋大学 VBL の設備を利用し て行った。本研究の一部は、東北大学電気通信研究所 共同プロジェクト研究の支援により行われた。



Fig. 1 I-V characteristics of the Fe_3Si -NDs with and without magnetic field (0.5 or 4.5kOe) at room temperature. A schematic view of an experimental set up for local I-V measurements is shown in the inset.



Fig. 2 Room temperature I-V characteristics of the Fe_3Si -NDs with a magnetic field of 0.5 kOe at different magnetic polarities in surface normal.